

InGaAs фотодиод 2200 нм, 1000 мкм, ТО-корпус — техническое описание

P/N : WIT4-1000G

ОСОБЕННОСТИ

Высокая чувствительность
Низкий темновой ток; спектральная чувствительность 900–2200 нм

ПРИМЕНЕНИЕ

Датчики CO₂; оптические датчики; измерители оптической мощности; измерение спектральной чувствительности

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Параметр	Обозначение	Мин.	Макс.	Ед. изм.
Рабочая температура	TSTG	°C	-55	125
Температура хранения	TC	°C	-40	85
Температура (время) пайки	TL	°C		260 / 10 с

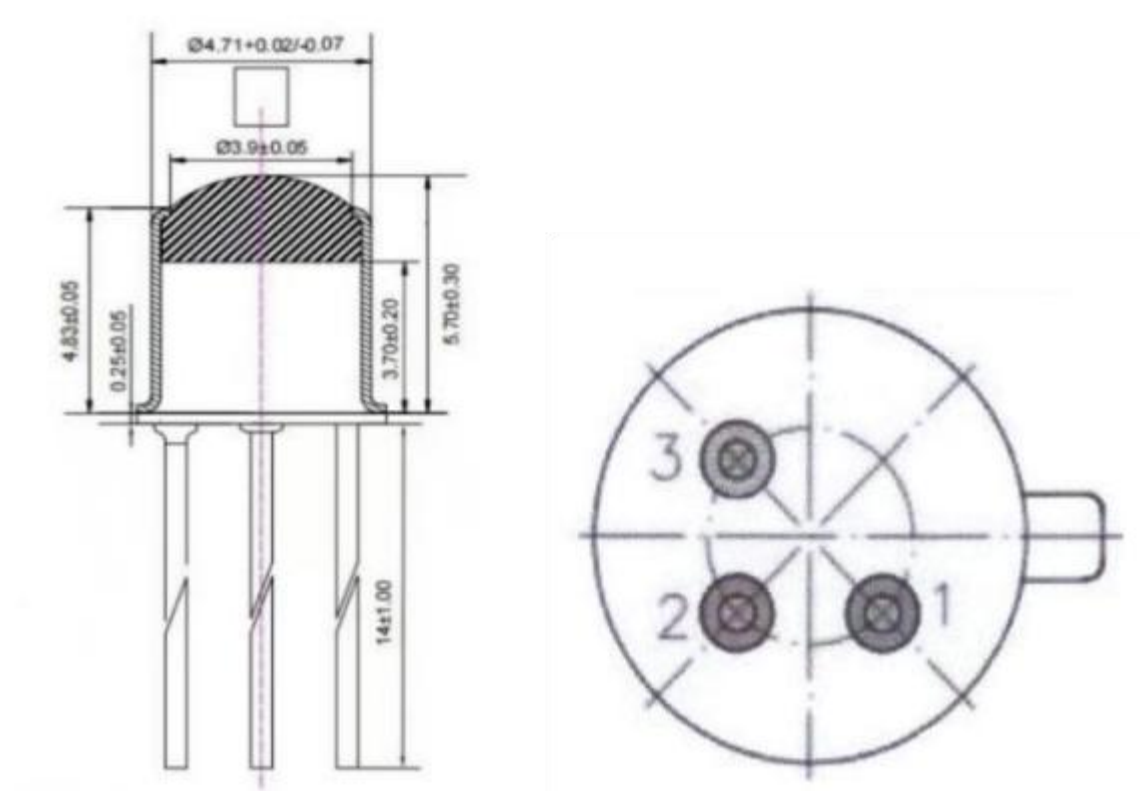
Электрооптические характеристики (T=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Активная область	D	-	995	1000	1005	мкм
Темновой ток	ID	Vr=-0.5V	-	-	9	мкА
Спектральная чувствительность	λ	-	900	2004	2200	нм
Чувствительность	R	Vr =0V,@2000 nm	0.9	1.0		А/Вт
Емкость	C	VBR=-5V		440	1000	пФ

ПРИМЕЧАНИЕ

При хранении, транспортировке и использовании рекомендуются соответствующие меры защиты от ЭСР.

Назначение выводов и габаритный чертёж



№ вывода	Название
1	PD+
2	PD-
3	GND